



Ministerio de Economía y Competitividad
Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación

Currículum

Nombre: José Ignacio Izpura Torres

Fecha: 10-Enero-2020

Apellidos: Izpura Torres
DNI: 15841226

Fecha de nacimiento : 18-01-1960

Nombre: José Ignacio
Sexo: V

Situación profesional actual

Entidad: Universidad Politécnica de Madrid
Facultad, Escuela o Instituto: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE)
Dpto./Secc./Unidad: Infraestructura, Sistemas Aeroespaciales y Aeropuertos
Dirección postal: Plaza Cardenal Cisneros 3, Ciudad Universitaria, 28040-Madrid

Teléfono (indicar prefijo, número y extensión): 913364490 Fax: 913366633
Correo electrónico: joseignacio.izpura@upm.es

Especialización (Códigos Unesco): 3307.03, 3307.07, 3307.09, 3307.14, 3307.19, 3307.91, 3307.92

Categoría profesional: Catedrático Universidad Fecha de inicio: 08/10/2012

Situación administrativa

Plantilla Contratado Interino Becario
 Otras situaciones especificar:

Dedicación A tiempo completo
A tiempo parcial

Líneas de investigación

Breve descripción, por medio de palabras clave, de la especialización y de las líneas de investigación actuales.

**Caracterización electrónica y optoelectrónica de dispositivos. Ruido eléctrico en dispositivos.
Ruido de fase. Microsensores y sistemas electrónicos asociados.**

Formación académica

Titulación superior	Centro	Fecha
Ingeniero de Telecomunicación (calificación: Sobresaliente)	ETSI Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Plan 64M (6 años)	Febrero 1983
Ingeniero Técnico de Armamento y Construcción (2º de la Promoc.)	Escuela Politécnica Superior del Ejército (EPSE)	Julio 1984

Doctorado	Centro	Fecha
Doctor Ing. Telecomunicación	ETSI Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)	Octubre 1989

Actividades anteriores de carácter científico profesional

Puesto	Institución	Fechas
Ing. Téc. Armamento y Construcción	Ejército de Tierra, 1ª Reg. Militar	Julio 1984 → Octubre 1984
Profesor Colaborador	ETSI Telecomunicación - UPM	Nov. 1984 → Sept. 1987
Profesor Asociado	ETSI Telecomunicación - UPM	Octubre 1987 → Nov. 1989
Profesor Titular Universidad interino	ETSI Telecomunicación - UPM	Dic. 1989 → Diciem. 1990
Profesor Titular Universidad	ETSI Telecomunicación - UPM	Enero 1991 → Oct. 2012

Idiomas (R = regular, B = bien, C = correctamente)

Idioma	Habla	Lee	Escribe
Inglés	B	B	B
Francés	B	C	B

Participación en proyectos de I+D+i financiados en convocatorias públicas.

(nacionales y/o internacionales)

En 43 Proyectos como investigador:

Título del proyecto:

Duración: Investigador Principal:

Entidad financiadora:

[1] *“Tecnología, fabricación y caracterización de dispositivos III-V para comunicaciones ópticas en el rango de 0.8-1.6 micras”*

1983-1986. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).

Financiación : CAICYT (Comisión Asesora Interministerial de Ciencia y Tecnología).

[2] *“Programa de Infraestructura de Laboratorio: producción de láminas III-V por epitaxia en fase líquida para AlGaAs e InGaAs”*

1986-1987. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).

Financiación : C.N.M. - CSIC.

[3] *“Medida de Niveles Profundos por Técnicas de Transitorios de Capacidad Bajo Condiciones de Resonancia Eléctrica”*

1983-1988. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).

Financiación: Proyecto Cooperativo del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, **Nº 8411043**.

[4] *“Fabricación y Caracterización de Dispositivos basados en estructuras de pozo cuántico y superred mediante epitaxia de haz molecular para su aplicación en microelectrónica y comunicaciones ópticas”*

1988-1990. Investigador Principal: Enrique Calleja Pardo (ETSIT-UPM).

Financiación: CICYT **Nº ME87-5**.

[5] *“Improved Picosecond Optical Switching with III-V Quantum Well Structures”*

1989-1991. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).

Partners: Imperial College, Dublin (Ireland), U.P.M. (Spain)

Financiación: Unión Europea **STIMULATION SCI-0172C**.

[6] *“Limiting Factors in III-V Semiconductor Devices due to Donor-related Deep States”*

1989-1991. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).

Financiación: Unión Europea **ESPRIT-3168**.

[7] *“Factores Limitativos en Dispositivos Semiconductores III-V debidos a Niveles Profundos Relacionados con el Donante (Centros DX)”*

1989-1991. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).

Financiación: CICYT **MAT89-692-CE**.

[8] *“Electrical Behavior of N-type Dopants in AlGaAs Alloys: Shallow Levels and DX centers”*

1988-1990. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).

Financiación: Air Force Office of Scientific Research, **AFOSR-88-0316**.

[9] *“Advanced GaInAs Based Transistors for High Speed Integrated Circuits”*

1989-1991. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).

Financiación: Unión Europea **ESPRIT-2035**.

[10] *“Caracterización de Transistores Avanzados Basados en GaInAs para Circuitos Integrados de Alta Velocidad”*

1989-1991. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).

Financiación: D. Gral. de Telecomunicaciones **PRONTIC, No. 308.89.12.781.00**.

[11] *"Receptores Integrados para Comunicaciones por Fibra Optica a Alta Velocidad (2 Gbps)"*
1990-1993. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).
Financiación: **DGT-PRONTIC, TIC90-0140-CO2-01 y TIC92-1154-3.**

[12] *"Buffer Layer Engineering in Semiconductors"*
1992-1994. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).
Financiación: Unión Europea **ESPRIT-Basic 6854 (BLES).**

[13] *"Ingeniería de Capas de Adaptación en Semiconductores"*
1992-1994. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).
Financiación: **CICYT, MAT93-0876CE, AEMAT93-1327E, MAT94-0801C3.**

[14] *"Electronic Transport parallel and through Interfaces"*
1992-1995. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).
Financiación: Unión Europea **ESPRIT ELTRASIN Working Group.**

[15] *"Strained Semiconductor Structures and Devices"*
1995-1997. Investigador Principal: Elías Muñoz Merino (ETSIT-UPM).
Financiación: Unión Europea, Human Capital and Mobility, **SQUAD Network ERBCHRXCT-94-0428.**

[16] *"Fabricación de un detector de Infrarrojos basados en Superredes y automatización de la caracterización de fotodetectores"*
1996-1997. Investigador Principal: José Luis Sánchez-Rojas Aldavero (ETSIT-UPM).
Financiación : CICYT - Acción Especial **TIC96-1930-E.**

[17] *"Desarrollo de un detector de IR basado en Superredes"*
1996-1997. Investigador Principal: José Luis Sánchez-Rojas Aldavero (ETSIT-UPM).
Financiación : Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA). Proyecto **P96 0920 225** entre Univ. Politéc. Madrid (UPM) y el CIDA bajo el Programa Coincidente.

[18] *"Superredes para Fotodetectores de IR y Realización de un detector de IR bicolor, I"*
1997-1998. Investigador Principal: José Luis Sánchez-Rojas Aldavero (ETSIT-UPM).
Financiación : Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA). Proyecto **P97 0920 282** entre Univ. Politéc. Madrid (UPM) y el CIDA bajo el Programa Coincidente.

[19] *"Superredes para Fotodetectores de IR y Realización de un detector de IR bicolor, II"*
1998-1999. Investigador Principal: José Luis Sánchez-Rojas Aldavero (ETSIT-UPM).
Financiación : Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA). Proyecto **P97 0920 411** entre Univ. Politéc. Madrid (UPM) y el CIDA bajo el Programa Coincidente.

[20] *"Desarrollo de un detector IR bicolor de pozos cuánticos"*
1999-2000. Investigador Principal: José Luis Sánchez-Rojas Aldavero (ETSIT-UPM).
Financiación : Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA). Proyecto **P99 0920 182** entre Univ. Politéc. Madrid (UPM) y el CIDA bajo el Programa Coincidente.

[21] *"Optimización de un detector IR de pozos cuánticos a 4.4 micras. Estudio del desarrollo de matrices de plano focal"*
Enero-2000- Diciembre 2000. Investigador Principal: José Luis Sánchez-Rojas Aldavero (ETSIT-UPM).
Financiación : Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA). Proyecto **P00 0920 209** entre la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el CIDA bajo el Programa Coincidente.

[22] *"Aplicación de la Microscopía de fuerzas atómicas y Espectroscopía de fuerzas de una sola molécula para la caracterización e inmovilización de genes en Nanobiodispositivos"*
2001-2004. Investigador Principal: José Luis Sánchez de Rojas Aldavero (ETSIT-UPM y ETSII-UCLM).
Financiación: CICYT **BIO2001-1235-C03-02.**

[23] "Tecnología de fabricación de dispositivos de alta frecuencia basados en nitruros para operación en alta temperatura", 2001-2004. Investigador Principal: Fernando Calle Gómez (ETSIT-UPM). Financiación: CICYT **TIC2001-2794**.

[24] "*Red temática de fabricación y aplicaciones de materiales ópticos*"
Años: 2002 y 2003. Coordinador: Universidad Miguel Hernández (Elche, Alicante)
Financiación: **OPVI 2002-52**, Consellería de Innovación y Competitividad, Comunidad Valenciana.

[25] "*Desarrollo de nanobiochips de ADN con tecnología micro/nanoelectrónica*"
Dic. 2002-Dic. 2005. Investigador Principal: Francisco Javier Tamayo (Instituto de Microelectrónica de Madrid). Financiación: CICYT **GEN2001-4856-C13-11**. Importe total del proyecto: 378.000 euros.

[26] "*Nuevas estrategias para la hibridación, automatización y miniaturización en sistemas analíticos, hidrodinámicos y electroforéticos*", Dic. 2004-Dic. 2007. Investigador Principal: Angel Ríos Castro (ETSII-UCLM). Financiación: MCYT **CTQ2004-02362/BQU**.

[27] "*Diseño y caracterización de MEMS piezoeléctricos para sensores y análisis químicos*"
Jul.. 2005-Jun. 2008. Investigador Principal: José Luis Sánchez de Rojas Aldavero (ETSII-UCLM). Financiación: **PAC-05-001-2**, (FEDER/FSE y Junta de Com. Castilla-La Mancha)

[28] "*Detección eléctrica de resonancias mecánicas en microrresonadores basados en actuación piezoeléctrica con Nitruro de Aluminio*". Duración: Año 2007. Financiación: 40.000 euros. Investigador Principal: Marta Clement (GMME-UPM). Programa cofinanciado entre la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el IV Programa de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (**PRICIT**) de la Comunidad de Madrid. Nº de Investigadores participantes: 8.

[29] "*Películas delgadas de materiales piezoeléctricos para aplicaciones en resonadores de ondas acústicas de volumen: Nitruro de Aluminio y nuevos óxidos ferroeléctricos*" (ALNOXBAW)", Oct. 2007-Sept. 2010. Investigador Principal: Enrique Iborra Grau. (GMME-UPM). Financiación: MCYT **MAT2007-62162**. Importe total del proyecto: 174.000 euros. Nº de Investigadores participantes: 8.

[30] "*Materiales electrónicos en película delgada I*".
Duración: Año 2008. Financiación: 8.336 euros. Investigador Principal: Enrique Iborra Grau (GMME-UPM). Programa de **Creación y Consolidación de Grupos de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, (Modalidad A)**

[31] "*Oxidos complejos piezoeléctricos para aplicaciones en MEMS y filtros de alta frecuencia*".
Duración: Año 2008. Financiación: 16.000 euros. Investigador Principal: Jimena Olivares (GMME-UPM). Programa cofinanciado entre la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el IV Programa de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (**PRICIT**) de la Comunidad de Madrid.

[32] "*Sistemas Micro-Electromecánicos (MEMS) para la automatización y desarrollo de nanotecnología analítica*". Enero 2008-Enero. 2011. Investigador Principal: José Luis Sánchez de Rojas Aldavero (ETSII-UCLM). Financiación: **PCC08-0015-0722**, (FEDER/FSE y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)

[33] "*Materiales electrónicos en película delgada I*". Duración: Año 2008. Financiación: 8.000 euros. Investigador Principal: Enrique Iborra Grau (GMME-UPM). Programa de **Creación y Consolidación de Grupos de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, (Modalidad A)**. Nº de Investigadores participantes: 8.

[34] "*Materiales electrónicos en película delgada I*". Duración: Año 2009. Financiación: 6.000 euros. Investigador Principal: Enrique Iborra Grau (GMME-UPM). Programa de **Creación y Consolidación de Grupos de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, (Modalidad A)**. Nº de Investigadores participantes: 8.

[35] *“Materiales electrónicos en película delgada III”*. Duración: Año 2010. Financiación: 16.650 euros. Investigador Principal: Enrique Iborra Grau (GMME-UPM). Programa de **Creación y Consolidación de Grupos de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, (Modalidad A)**. Nº de Investigadores participantes: 8.

[36] *“Materiales electrónicos en película delgada IV”*. Duración: Año 2011. Financiación: 4.500 euros. Investigador Principal: Enrique Iborra Grau (GMME-UPM). Programa de **Creación y Consolidación de Grupos de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, (Modalidad A)**. Nº de Investigadores participantes: 8.

[37] *“Materiales electrónicos en película delgada V”*. Duración: Año 2012. Financiación: 4.000 euros. Investigador Principal: Enrique Iborra Grau (GMME-UPM). Programa de **Creación y Consolidación de Grupos de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, (Modalidad A)**. Nº de Investigadores participantes: 8.

[38] *“Materiales multifuncionales en película delgada para dispositivos piezoeléctricos avanzados (resonadores acústicos y sensores MEMS). (MAREA)”*, Enero 2011-Diciembre 2013. Investigador Principal: Dr. Marta Clement Lorenzo. (GMME-UPM). Financiación: MCYT **MAT2010-18933**. Importe total del proyecto: 247.000 euros. Nº de Investigadores participantes: 8.

[39] *“Integración de Resonadores BAW basados en AIN con frecuencias sustancialmente distintas en el mismo sustrato (INTERES)”*, Duración: Año 2011. Financiación: 10.300 euros. Investigador Principal: Jimena Olivares Roza (GMME-UPM). Programa cofinanciado entre la UPM y el IV Programa de Invest. Científica e Innovac. Tecnológica (**PRICIT**) de la CAM. Nº de Investigadores participantes: 8.

[40] *“Rapid Aptamer Based Diagnostics for Bacterial Meningitis”*, Duración: 2012-2015. Investigador Principal: Morten A. Geday (ETSIT-UPM). Financiación: 1.124.000 euros (UPM), Unión Europea **FP7-HEALTH F3-2012.2.3.0-1-304814 (RAPTADIAG)**.

[41] *“Integrating devices and materials: a challenge for new instrumentation in ICT”*. Investigador Principal: José Manuel Otón. **COST IC1208**. VII Programa Marco de la UE. 2013-2016.

[42] *“Materiales avanzados para biosensores basados en resonadores piezoeléctricos combinados con nanotubos de carbono y grafeno”*, Enero 2013-Diciembre 2016. Investigador Principal: Enrique Iborra Grau. (GMME-UPM). Financiación: MCYT **MAT2013-45957-R**. Importe total del proyecto: 180.000 euros. Nº de Investigadores participantes: 6.

[43] *“Sensores gravimétricos de gases basados en resonadores electroacústicos de película delgada de AIN para aplicaciones de temperaturas extremas”* (SEGALN) Enero 2017-Diciembre 2019. Investigador Principal: Enrique Iborra Grau. (GMME-UPM). Financiación: MCYT **MAT2017-84817-C2-1-R**. Importe: 198.440 euros. Nº de Investigadores participantes: 6.

En 10 Proyectos como Investigador Principal y/o Coordinador:

Entidad financiadora. Cantidad concedida.

Título del proyecto:

Fechas de inicio y de final del Proyecto. Número equiv. a jornada completa (EJC) de participantes.

Socios (en su caso). Tipo de participación (Coordinador, Investigador Principal)

[1] Financiación: CICYT **TIC93-0026**. Cantidad concedida: **9.988.000 pts**.

“Desarrollo de nuevos diodos de efecto túnel resonante para mezcladores y osciladores en ondas milimétricas”, Abril 1993 - Marzo 1995. EJC: **5. Investigador Principal**.

[2] Financiación: CICYT **TIC95-0116**. Cantidad concedida: **15.300.000 pts**.
"Diseño y fabricación de moduladores piezo-electroópticos para comunicaciones ópticas (1,5 micras)"
Junio 1995 - Mayo 1998. EJC: **5. Investigador Principal**.

[3] Financiación: Unión Europea **ESPRIT 25112**. Cantidad concedida total: **100 Kecu (16.638.600 pts)**.
"GaAs High Index Substrates for Optoelectronics (GHISO)". RTD Project Open LTR Scheme, Phase I.
Octubre 1997-Junio 1998 (9 meses). EJC: **5. Project Coordinator e Investigador Principal de UPM**.
Socios: Univ. Sheffield (U.K.), CNRS-LAAS Toulouse (France), Thomson-LCR (France) y Universidad
Politécnica de Madrid, UPM (Spain). Cantidad de UPM: **23 Kecu (3.826.878 pts)**. EJC de UPM: **1.5**.

[4] Financiación: Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y USA.
Proyecto Conjunto N° 98050. Cantidad concedida: **4.899.770 pts**.
"Estudio Comparativo de las propiedades optoelectrónicas de pozos cuánticos
piezoeléctricos MBE(111)B y MOVPE(111)A", Mayo 1998-Abril 2000. EJC: **2. Project Coordinator e Investigador Principal de UPM**. Socios: Universidad de Boulder, Colorado (USA) y U.P.M.
Parte de la cantidad concedida correspondiente a UPM: **2.940.000 pts (60% del total)**.

[5] Financiación: CICYT **MAT98-1283-CE**. Cantidad concedida: **3.795.000 pts**.
"Substratos de AsGa de alto Índice para Optoelectrónica"
Octubre 1998-Septiembre 1999. **Investigador Principal**. EJC: **1.5**.

[6] Financiación: CICYT TIC98-0826-CO2-01. Cantidad concedida: **14.400.000 pts**.
"Láseres sintonizables en la banda de 1-1.3 micras sobre sustratos de GaAs[111]B", Diciembre 1998-
Noviembre 2001. EJC: **5. Coordinador e Investigador Principal de UPM**. Socios: Universidad de Cádiz
y U.P.M. Cantidad correspondiente a UPM: 6.900.000 pts. EJC de UPM: **2.5**.

[7] Financiación: Unión Europea **ESPRIT 35112**. Cantidad concedida total: **840 Kecu (139.764.240 pts)**
"GaAs High Index Substrates for Optoelectronics (GHISO Phase II)"
Enero 1999-Diciembre 2000. EJC: **16. Project Coordinator e Investigador Principal de UPM**.
Socios: Univ. Sheffield (U.K.), CNRS-LAAS Toulouse (France), Thomson-LCR (France), UPM (Spain).
Parte de la cantidad concedida correspondiente a UPM: **240 Kecu (39.932.640 pts)**. EJC de UPM: **5**.

[8] Financiación : CICYT TIC1999-1436-CE. Cantidad concedida: **14.974.700 pts**.
"Complemento al Proyecto GHISO (GaAs High Index Substrates for Optoelectronics)".
Julio 2000-Junio 2001. EJC: **5. Investigador Principal**.

[9] Financiación: Ministerio de Defensa. Centro Nacional de Inteligencia. Cantidad contratada **24 Keuros**.
Sistemas de monitorización y control de líneas y emisión EM.
Julio 2003-Noviembre 2003. EJC: **1. Investigador Principal**.

[10] Financiación: Ministerio de Defensa. Centro Nacional de Inteligencia. Cantidad contratada **12 Keuros**. *KIFOAP: Kit de Fibra Óptica de Altas Prestaciones*.
Julio 2004-Noviembre 2004. EJC: **1. Investigador Principal**.

Total contratado: **668 Keuros (111.150.482 pts)**

Título del proyecto:

Entidad financiadora:

Entidades participantes:

Duración, desde:

hasta:

Cuantía de la subvención:

Investigador responsable:

Número de investigadores participantes:

Publicaciones o documentos científico-técnicos

(CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = "review", E = editor,
S = Documento científico-técnico restringido)

[1] **J.I. IZPURA**

"Técnicas de caracterización electroóptica de diodos electroluminiscentes de alta eficiencia"
Proyecto Fin de Carrera. ETSI Telecomunicación, Madrid (Febrero 1983) **L**

[2] **J.I. IZPURA**, J.M. HERRERO, F. SANDOVAL, E. CALLEJA, A. DE LA CRUZ, E. MUÑOZ
"Deep level spectroscopy by transient capacitance techniques under electrical resonance"
IEEE Trans. Instrument. and Measurements N-1, Vol. IM-33, 16-18 (1984) **A**

[3] P. CAMARA, E. MUÑOZ, **I. IZPURA**, J. LABLANCA, E. LAPEÑA, M.A. PATE, G. HILL,
P. MISTRY, J. ROBERTS, H.Y. HALL
"Emitter Concentration and Interface Effects in the Base-Emitter Characteristics of GaAlAs/GaAs
Heterojunction Bipolar Transistors"
Solid State Devices. North Holland, 979-982 (1988) **A**

[4] **I. IZPURA**, E. MUÑOZ
"Electron Capture by DX Centers in AlGaAs and Related Compounds"
Appl. Phys. Lett., 55 (17), 1732-1734 (1989) **A**

[5] **J.I. IZPURA**

"Contribución al estudio de transistores bipolares de AlGaAs/GaAs: estudio de las zonas tipo N"
Tesis Doctoral E.T.S.I.T. Madrid. (Octubre 1989) **L**

[6] **I. IZPURA**, E. MUÑOZ, G. HILL, J. ROBERTS, M.A. PATE, P. MISTRY, N.Y. HALL
"Capacitance properties in N-type Al Ga As"
Appl. Phys. Lett. - Vol. 55, 2414-2416, (1989) **A**

[7] F. SANDOVAL, J.R. DE DIEGO, **I. IZPURA**
"Minority carrier lifetime and efficiency in single heterostructure AlGaAs red light emitting diodes"
Int. Journal of Electronics. - Vol. 67, 853-864, (1989) **A**

[8] **I. IZPURA**, E. MUÑOZ, E. CALLEJA, G. HILL, J. ROBERTS, M.A. PATE, P. MISTRY, N.Y. HALL
"DX Centers and the Low Temperature Behavior of AlGaAs/GaAs Heterojunction Bipolar Transistors"
In Defect Control in Semiconductors, K. Sumino (ed),
Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland), 1267-1272, (1990) **A**

[9] **I. IZPURA**, E. MUÑOZ, F. GARCIA, E. CALLEJA, A.L. POWELL, P.I. ROCKETT,
C.C. BUTTON, J.S. ROBERTS
"Impact Ionization of Se Related DX Centers in AlGaAs"
Appl. Phys. Lett. - Vol. 58, 735-737, (1991) **A**

[10] S. DUEÑAS, **I. IZPURA**, J. ARIAS, J. BARBOLLA
"Characterization of the DX Centers in AlGaAs:Si by Admittance Spectroscopy"
J. Appl. Phys. 69 (8), 4300-4305, (1991) **A**

[11] L. ENRIQUEZ, S. DUEÑAS, J. BARBOLLA, **J.I. IZPURA**, E. MUÑOZ
"Influence of refilling effects on deep-level transient spectroscopy measurements in Se-doped Al_xGa_{1-x}As"
J. Appl. Phys., 72 (2), 525-530 (1992) **A**

Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso.

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos (cont.)

(CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = "review",
E = editor, S = Documento Científico-Técnico restringido.)

Autores (p.o. de firma):

Título:

Ref. revista / Libro: Volumen: Páginas inicial,- final: (Fecha) Clave:

- [12] E. MUÑOZ, E. CALLEJA, F. GARCIA, **I. IZPURA**, J.L. SANCHEZ-ROJAS
"Influence of DX Centers on HEMT Performance"
Alta Frecuencia, 3, 3/51-11/59 (1993) **A**
- [13] E. MUÑOZ, E. CALLEJA, **I. IZPURA**, F. GARCIA, A.L. ROMERO, J.L. SANCHEZ-ROJAS,
A.L. POWELL, J. CASTAGNE
"Techniques to Minimize DX Center Deleterious Effects in III-V Device Performance"
J. Appl. Phys., 73 (10), 4988-4997 (1993) **A**
- [14] **I. IZPURA**, E. MUÑOZ, E. CALLEJA
"A Critical Analysis of Capacitance Transient Signals Due to DX Centers in n-type AlGaAs"
Semicond. Sci. Technol., 8, 1258-1266 (1993) **A**
- [15] J.M. HERNANDEZ, **I. IZPURA**, E. CALLEJA, E. MUÑOZ
"Piezoelectric-induced Current Asymmetry in [111] InGaAs/InAlAs Resonant Tunneling Diodes
for Microwave Mixing"
Appl. Phys. Lett., 63 (6), 773-775 (1993) **A**
- [16] **I. IZPURA**, E. MUÑOZ, E. CALLEJA, F. GARCIA
"DX Centers in reduced dimensionality n-type AlGaAs structures"
in "Defects in Semiconductors", ed. by H. Heinrich and W. Jantsch, Materials Science Forum
Vol. 143-147, 623-628, Trans Tech Publications (1994) **A**
- [17] E. CALLEJA, **I. IZPURA**
"Deep Level Transient Spectroscopy of DX Centers"
in "DX Centers. Donors in AlGaAs and Related Compounds", ed. by E. Muñoz,
Defect and Diffusion Forum Vol. 108, 75-96, Scitec Publications ISBN 3-908450-03-9 (1994) **CL**
- [18] C.M. ALDAO, J.F. VALTUEÑA, **I. IZPURA**, E. MUÑOZ
"Surface Photovoltages Due to Pulsed Sources: Implications for Photoemission Spectroscopy"
Phys. Rev. B., Rapid Communications, Vol. 50, 17729-17731 (1994) **A**
- [19] **I. IZPURA**, A. MONDARAY, E. MUÑOZ, E. CALLEJA
"On the Spectroscopy of DX Centers by Transient Techniques at Constant Capacitance"
Semicond. Sci. Technol. 10 (1), 25-31 (1995) **A**
- [20] J.F. VALTUEÑA, **I. IZPURA**, J.L. SANCHEZ-ROJAS, A. SACEDON, E. CALLEJA,
E. MUÑOZ
"Displacement Photocurrents and Screening Effects in Novel Piezoelectric InGaAs/GaAs MQW
P-I-N Diodes"
Semicond. Sci. Technol., 10, 1528-1533 (1995) **A**
- [21] J.L. SANCHEZ-ROJAS, E. MUÑOZ, A. SACEDON, J.F. VALTUEÑA, **I. IZPURA**, E. CALLEJA
"Field Control in Piezoelectric [111]-Oriented InGaAs/GaAs MQW and Superlattice Devices"
IEEE Proc. Catalog number 95CH35735, 506-515 (1995) **A**

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos (cont.)

(CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = "review",
E = editor, S = Documento Científico-Técnico restringido.)

Autores (p.o. de firma):

Título:

Ref. revista / Libro: Volumen: Páginas inicial,- final: (Fecha) Clave:

- [22] **I. IZPURA**, J.F. VALTUEÑA, J.L. SANCHEZ-ROJAS, A. SACEDON, E. CALLEJA, E. MUÑOZ
"Transient Negative Photocurrent and Out-of-Well Dipole Kinetics in Novel Piezoelectric
InGaAs/GaAs MQW P-I-N Diodes"
Solid St. Electron., 40, 463-467 (1996) **A**
- [23] F.J. SANCHEZ, D. BASAK, M.A. SANCHEZ-GARCIA, E. CALLEJA, E. MUÑOZ, **I. IZPURA**, F. CALLE,
J.M.G. TIJERO, B. BEAUMONT, P. LORENZINI, P. GIBART, T.S. CHENG, C.T. FOXON, J.W. ORTON
"Yellow Band and Deep Levels in Undoped MOVPE GaN"
Proc. EGW-1. MRS Internet Journal on Nitride Semicond. Research, 1, 147 (1996) **A**
- [24] **I. IZPURA**, E. MUÑOZ
"Epitaxial photoconductive detectors: a kind of photo-FET devices"
IEEE Proc. No. 97TH8292, 73-80 (1996) **A**
- [25] J.F. VALTUEÑA, **I. IZPURA**, J.L. SANCHEZ-ROJAS, E. MUÑOZ, E.A. KHOO,
J.P.R. DAVID, J. WOODHEAD, R. GREY, G.J. REES
"Memory Effects on Piezoelectric InGaAs/GaAs MQW PIN diodes"
Microelectronics Journal 28, 757-765 (1997) **A**
- [26] J.L. SANCHEZ-ROJAS, A. SACEDON, J.F. VALTUEÑA, A. SANZ-HERVAS,
I. IZPURA, E. CALLEJA, E. MUÑOZ, E.J. ABRIL, M. AGUILAR
"Charge Accumulation Effects in InGaAs/GaAs [111]-Oriented Piezoelectric Multiple Quantum Wells"
Microelectronics Journal 28, 767-775 (1997) **A**
- [27] E. CALLEJA, F.J. SANCHEZ, D. BASAK, M.A. SANCHEZ-GARCIA, E. MUÑOZ, **I. IZPURA**, F. CALLE,
J.M.G. TIJERO, J.L. SANCHEZ-ROJAS, B. BEAUMONT, P. LORENZINI, P. GIBART
"Yellow Luminescence and Related Deep States in undoped GaN"
Phys. Rev. B., 55, 4689-4694 (1997) **A**
- [28] **I. IZPURA**, J.F. VALTUEÑA, E. MUÑOZ
"Surface band-bending assessment by photocurrent techniques. Application to III-V semiconductors"
Semicond. Sci. Technol. 12, 678-686 (1997) **A**
- [29] J.F. VALTUEÑA, A. SACEDÓN, A.L. ALVAREZ, **I. IZPURA**, F. CALLE, E. CALLEJA,
G. MACPERSON, P.J. GOODHEW, F.J. PACHECO, R. GARCIA, S.I. MOLINA
"Influence of the surface morphology on the relaxation of low strained $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ linear buffer structures"
J. Crystal Growth 182, 281-291 (1997) **A**
- [30] E. MUÑOZ, E. MONROY, J.A. GARRIDO, **I. IZPURA**, F.J. SANCHEZ,
M.A. SANCHEZ-GARCIA, E. CALLEJA, B. BEAUMONT, P. GIBART
"Photoconductor Gain Mechanisms in GaN Ultraviolet Detectors"
Appl. Phys Lett., Vol. 71 (7) 870-872 (1997) **A**
- [31] E. MONROY, J.A. GARRIDO, E. MUÑOZ, **I. IZPURA**, F.J. SANCHEZ,
M.A. SANCHEZ-GARCIA, E. CALLEJA, B. BEAUMONT, P. GIBART
"Characterization and modelling of Photoconductive GaN Ultraviolet Detectors"
Proc. EGW-2. MRS Internet Journal on Nitride Semicond. Research, 2, 12 (1997) **A**

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos (cont.)

(CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = "review",
E = editor, S = Documento Científico-Técnico restringido.)

Autores (p.o. de firma):

Título:

Ref. revista / Libro: Volumen: Páginas inicial,- final: (Fecha) Clave:

[32] **I. IZPURA**, E. MUÑOZ

"Epitaxial photoconductive detectors: a kind of photo-FET devices"

Actas de la 1ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE97). Barcelona,
Servei de Publicacions de la UPC, 151-156 (1997)

A

[33] J.L. SANCHEZ-ROJAS, E. MUÑOZ, A. SACEDON, J.F. VALTUEÑA, **I. IZPURA**, E. CALLEJA

"Optoelectronic properties of piezoelectric [111]-oriented InGaAs/GaAs MQW and superlattice devices"

Actas de la 1ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE97). Barcelona,
Servei de Publicacions de la UPC, 451-456 (1997)

A

[34] A. SANZ-HERVAS, J.F. VALTUEÑA, M. GARRIDO, J.P.R. DAVID, C.VILLAR, E.J. ABRIL

M. AGUILAR, **I. IZPURA**, R. GREY, F. GONZALEZ-SANZ, R. LORENZO, M. LOPEZ

"High-resolution X-ray diffraction study of partially relaxed InGaAs/GaAs multiquantum well
p-i-n diodes on (001) GaAs"

Proc. ICDD 1997, Internacional Centre for Diffraction Data. Advances in X-ray Analysis, Vol. 40 (1997)

A

[35] J.F. VALTUEÑA, J.A. GARRIDO, **I. IZPURA**

"1/f noise in InGaAs/GaAs linear graded buffer layers"

IEEE Trans. on Electron Devices, Vol. 45 (6) 1201-1206 (1998)

A

[36] J.A. GARRIDO, E. MONROY, **I. IZPURA**, E. MUÑOZ

"Photoconductive gain modelling of GaN photodetectors"

Semiconductor Science and Technology, 13, 563-568 (1998)

A

[37] J.J. SANCHEZ, O. MARTY, M. HOPKINSON, **I. IZPURA**, A. GUZMAN, J.M.G. TIJERO

"Structural and morphological characteristics of InGaAs/GaAs quantum well structures on tilted
(111)B GaAs grown by MBE"

J. Crystal Growth 192, 363-371 (1998)

A

[38] J.A. GARRIDO, F. CALLE, E. MUÑOZ, **I. IZPURA**, J.L. SANCHEZ-ROJAS, R. LI, K.L. WANG

"Low frequency noise and screening effects in AlGaIn/GaN HEMTs"

Electronics Letters, Vol. 34 (24) 2357-2359 (1998)

A

[39] J.A. GARRIDO, F. CALLE, E. MUÑOZ, **I. IZPURA**, J.L. SANCHEZ-ROJAS, R. LI, K.L. WANG

"Low-frequency noise sources in AlGaIn/GaN HEMTs"

AIP Conf. Proceedings 466, 71-83. P.H. Handel A.L. Chung (ed). Woodbury- New York (1999)

A

[40] J.J. SANCHEZ, J.M.G. TIJERO, J. HERNANDO, J.L. SANCHEZ-ROJAS, **I. IZPURA**

"Optical investigation of the relaxation process in InGaAs/GaAs SSQW grown on (001) and (111)B
GaAs substrates"

Microelectronics Journal 30, 363-366 (1999)

A

[41] J.J. SANCHEZ, M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.M.G. TIJERO,

J.L. SANCHEZ-ROJAS, **I. IZPURA**, R. GARCIA

"Influence of substrate misorientation on the optical and structural properties of InGaAs/GaAs
Single Strained Quantum Wells grown on (111)B GaAs by Molecular Beam Epitaxy"

Microelectronics Journal 30, 373-378 (1999)

A

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos (cont.)

(CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = "review",
E = editor, S = Documento Científico-Técnico restringido.)

Autores (p.o. de firma):

Título:

Ref. revista / Libro: Volumen: Páginas inicial,- final: (Fecha) Clave:

- [42] M.J. ROMERO, M. GUTIERREZ, J.J. SANCHEZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON,
I. IZPURA, R. GARCIA
"Cathodoluminescence study of pyramidal facets in piezoelectric InGaAs/GaAs multiple quantum well
pin photodiodes"
Microelectronics Journal 30, 427-431 (1999) **A**
- [43] **J.I. IZPURA**, J.J. SANCHEZ, J.L. SANCHEZ-ROJAS, E. MUÑOZ
"Piezoelectric field determination in strained InGaAs quantum wells grown on [111]B GaAs substrates
by differential photocurrent"
Microelectronics Journal 30, 439-444 (1999) **A**
- [44] M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.J. SANCHEZ, **I. IZPURA**, R. GARCIA
"New relaxation mechanism in InGaAs/GaAs (111) multiple quantum well"
Microelectronics Journal 30, 467-470 (1999) **A**
- [45] M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.J. SANCHEZ,
I. IZPURA, M. HOPKINSON, R. GARCIA
"Influence of substrate misorientation on the structural characteristics of InGaAs/GaAs quantum wells
on (111)B GaAs grown by MBE"
Thin Solid Films 343-344, 558-561 (1999) **A**
- [46] M. HOPKINSON, J.J. SANCHEZ, M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON,
I. IZPURA, R. GARCIA
"Optical properties of $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ MQW structures on (111)B GaAs grown by MBE:
Dependence on substrate miscut"
J. Crystal Growth 201/202, 1085-1088 (1999) **A**
- [47] A. SANZ-HERVAS, C.VILLAR, M. GARRIDO, J.F. VALTUEÑA, J.P.R. DAVID, J.S. ROBERTS
M.A.G. HALLIWELL, E.J. ABRIL, M. LOPEZ, **I. IZPURA**
"Asymmetric lattice distortion in pseudomorphic multilayers grown on misoriented substrates"
Proc. ICDD 1999, Advances in X-ray Analysis, Vol. 41, 120-129 (1999) **A**
- [48] J.J. SANCHEZ, J.M.G. TIJERO, **I. IZPURA**, J.L. SANCHEZ-ROJAS, M. HOPKINSON
M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, R. GARCIA
"Relaxation study of $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ Quantum-Well structures grown by MBE on (001) and (111)B
GaAs for long wavelength applications"
J. Crystal Growth 206, 287-293 (1999) **A**
- [49] M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.J. SANCHEZ, **I. IZPURA**, R. GARCIA
"Study of the relaxation in InGaAs SQW grown on (111)B substrates"
Inst. Phys. Conf. Series No 164, pp. 223-226 (1999) **A**
- [50] E. MONROY, F. VIGUE, F. CALLE, **J.I. IZPURA**, E. MUÑOZ, J.P. FAURIE
"Time response analysis of ZnSe-based Schottky barrier photodetectors"
Appl. Phys Lett., Vol. 77 (17) 2761-2763 (2000) **A**

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos (cont.)

(CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = "review",
E = editor, S = Documento Científico-Técnico restringido.)

Autores (p.o. de firma):

Título:

Ref. revista / Libro: Volumen: Páginas inicial,- final: (Fecha) Clave:

- [51] M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.J. SANCHEZ, **I. IZPURA**, R. GARCIA
"Espesores críticos de relajación en pozos cuánticos de InGaAs/GaAs sobre sustratos
de GaAs(001) y (111)B"
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 39 (2000) 482-486 (2000) **A**
- [52] **J.I. IZPURA**
"Side contact effects on the capacitance properties of junction devices. Application to III-Nitrogen
structures"
Semiconductor Science and Technology, 16, 243-249 (2001) **A**
- [53] T. FLEISCHMANN, M. MORAN, M. HOPKINSON, H. MEIDIA, J.G. REES, A.G. CULLIS,
J.L. SANCHEZ-ROJAS, **I. IZPURA**.
"Strained layer (111)B GaAs/InGaAs single quantum well lasers and the dependence of their
characteristics upon indium composition".
J. Appl. Phys., 89 (9), 4689-4696 (2001) **A**
- [54] S. CHO, J. KIM, A. MAJERFELD, J.J. SANCHEZ, E. MUÑOZ, **I. IZPURA**
"Evaluation of strained piezoelectric InGaAs/GaAs QW structures grown on (111)B GaAs by
photoreflectance spectroscopy"
Proc. of the IEEE 27th Int. Symp. On Compound Semicond. ISCS-2000, Monterrey, California
IEEE Inst. Phys. Conf. Series, pp 273 ISBN: 0-7803-6285-6 (2001) **A**
- [55] S. CHO, A. MAJERFELD, A. SANZ-HERVAS, J.J. SANCHEZ, J.L. SANCHEZ-ROJAS,
I. IZPURA
"Determination of the pyroelectric coefficient in strained InGaAs/GaAs quantum wells grown
on (111)B GaAs substrates"
J. Appl. Phys., 90 (2), 915-917 (2001) **A**
- [56] J.J. SANCHEZ, **J.I. IZPURA**, J.M.G. TIJERO, E. MUÑOZ, S. CHO, A. MAJERFELD
"Confirmation of the pyroelectric coefficient of strained $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ /GaAs quantum well structures
grown on (111)B GaAs by differential photocurrent spectroscopy"
J. Appl. Phys., 91 (5), 3002-3006 (2002) **A**
- [57] M.GUTIERREZ, D.GONZÁLEZ, G.ARAGÓN, M.HOPKINSON, R.GARCÍA,
J.J.SÁNCHEZ, **I. IZPURA**
"Strain relaxation behavior of $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ quantum wells on vicinal GaAs (111)B substrates"
Appl. Phys Lett., Vol. 80 (9) 1541-1543 (2002) **A**
- [58] S. CHO, A. MAJERFELD, J.J. SÁNCHEZ, E. MUÑOZ, J.M.G. TIJERO, **I. IZPURA**
"Observation of the pyroelectric effect in strained Piezoelectric InGaAs/GaAs quantum-wells
grown on (111)B GaAs substrates"
Microelectronics Journal 33, 531-534 (2002) **A**
- [59] M. GUTIERREZ, M. HERRERA, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.J. SANCHEZ,
I. IZPURA, M. HOPKINSON, R. GARCIA
"Relaxation study of AlGaAs cladding layers in InGaAs/GaAs (111)B lasers designed for
1.0-1.1 μm operation"
Microelectronics Journal 33, 553-557 (2002) **A**

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos (cont.)

(CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = "review",
E = editor, S = Documento Científico-Técnico restringido.)

Autores (p.o. de firma):

Título:

Ref. revista / Libro: Volumen: Páginas inicial,- final: (Fecha) Clave:

- [60] M. HERRERA, M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, **I. IZPURA**,
M. HOPKINSON, R. GARCIA
"The role of climb and glide in misfit relief of InGaAs/GaAs (111)B Heterostructures"
Microelectronics Journal 33, 559-563 (2002) **A**
- [61] J.M. ULLOA, L. BORRUEL, J.M.G. TIJERO, J. TEMMYO, I. ESQUIVIAS,
I. IZPURA, J.L. SANCHEZ-ROJAS
"Spontaneous emission study of (111) InGaAs/GaAs Quantum Well lasers"
Microelectronics Journal 33, 589-593 (2002) **A**
- [62] **J. I. IZPURA**
"El papel de la resistencia de contacto de drenador en el colapso de Id en transistores FET de GaN para microondas"
Libro de Actas del Congreso URSI 2002, pp 201-202. ISBN 84 – 8138-517-4
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá de Henares.(2002) **A**
- [63] **J. I. IZPURA**
"Drain current collapse in GaN MESFETs due to surface band-bending effects"
Semiconductor Science and Technology, 17, 1293-1301 (2002) **A**
- [64] J.J. SANCHEZ, S.BLANC, C. GUERRET-PIECOURT, C. FONTAINE, R. MAMY, **I. IZPURA**
"Homoepitaxial layers on (111)B 1°off towards [-211] GaAs substrates grown by MBE:
influence of growth conditions on surface morphology"
Informe interno del LAAS-CNRS, Toulouse, Francia (2001)
http://dbserver.laas.fr/pls/LAAS/publis.rech_doc?langage=ENG&clef=44858 **S**
- [65] **J. I. IZPURA**
"Diseño con Amplificadores Operacionales: Control básico de las realimentaciones"
Fundación Rogelio Segovia para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FUNDETEL).
ETSIT-UPM. ISBN: 84-7402-306-8 (Mayo 2004) **L**
- [66] O. NIETO-TALADRIZ, A. ARAUJO, D. FRAGA, J.M. MONTERO, **J. I. IZPURA**
"Antares: A synergy between University Education and Research, Development and
Technology Innovation Groups", Proceedings of the Colloquium on Higher Education of Electronics in
Serbia, Nis, Serbia (2004), pp 9-22, ISBN 86-80135-88-7 **A**
- [67] A. ARAUJO, J.M. MONTERO, D. FRAGA, **J. I. IZPURA**, O. NIETO-TALADRIZ
"ANTARES: Una Integración de Docencia Universitaria e (I+D+I) en una misma Plataforma"
Libro de Resúmenes de Ponencias del VI Congreso sobre Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de
la Electrónica., pp 49. ISBN 84 – 688-7339-X. Valencia, España. (2004). (Ponencias en CDROM)
A
- [68] J.M. TIRADO, J.L. SANCHEZ-ROJAS, **J.I. IZPURA**
"2D simulation of static surface states in AlGaIn/GaN HEMT and GaN MESFET devices"
Semiconductor Science and Technology, 20, 864-869 (2005) **A**
- [69] **J. I. IZPURA**, J. MALO
"1/f noise enhancement in GaAs", 18th Int. Conf. on Noise and Fluctuations (ICNF-2005).
AIP Conf. Proceedings **780**, 113-116 (2005) **A**

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos (cont.)

(CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = "review",
E = editor, S = Documento Científico-Técnico restringido.)

Autores (p.o. de firma):

Título:

Ref. revista / Libro: Volumen: Páginas inicial,- final: (Fecha) Clave:

[70] J. M. TIRADO, J. L. SANCHEZ-ROJAS, **J. I. IZPURA**

"Numerical 2D simulation of surface states effects in AlGaIn/GaN HEMT and GaN MESFET devices"
Proceedings of **IEEE-NANO 2005**: 5th IEEE Conf. on Nanotechnology. Nagoya, Japan. July 12-14th
IEEE Catalog Number: 05TH8816C. ISBN: 0-7803-9200-0. (2005). **A**

[71] J. OLIVARES, J. MALO, S. GONZALEZ, E. IBORRA, **I. IZPURA**, M. CLEMENT, A. SANZ-HERVAS, J.L. SANCHEZ-ROJAS, P. SANZ

"Tunable mechanical resonator with aluminum nitride piezoelectric actuation"

Photonics-Europe Conf. on MEMS, MOEMS and Micromachining II. Strasbourg, France. April 3-7.
Proceedings of SPIE Vol. **6186**, pp. 61860K/1-61860K/12, ISBN: 0-8194-6242-X (2006) **A**

[72] **J. I. IZPURA**, J. MALO

"Noise tunability in planar junction diodes: theory, experiment and additional support by SPICE"
Resúmenes de trabajos (Libro+CDROM) del VII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica, (TAE'2006) Madrid, España. Julio 12-14, pp 63-64. ISBN 84-689-9590-8 (2006). **A**

[73] J. M. TIRADO, J. L. SANCHEZ-ROJAS, **J. I. IZPURA**

"Simulation of surface state effects in the transient response of AlGaIn/GaN HEMT and GaN MESFET devices"

Semiconductor Science and Technology, **21**, pp. 1150-1159 (2006) **A**

[74] J. MALO, **J. I. IZPURA**

"Simultaneous magnetic and electrostatic driving of microcantilevers"

Sensors and Actuators A: Phys. **136**, pp. 347-357 (2007) **A**

[75] **J. I. IZPURA**

"1/f electrical noise due to space charge regions"

Proc. of Electroceramics-X: International Conference on Electroceramics Toledo, Spain. June 18-22nd
J. Eur. Ceram. Soc. **27**, pp. 4011-4015 (2007) **A**

[76] J. M. TIRADO, J. L. SANCHEZ-ROJAS, **J. I. IZPURA**

"Trapping Effects in the Transient Response of AlGaIn/GaN HEMT Devices"

IEEE Trans. on Electron Devices, **54** (3) pp. 410-417 (2007) **A**

[77] J. MALO, **J. I. IZPURA**

"Feedback loops with electrically-driven cantilevers"

Microtechnologies for the New Millennium 2007, 2-4 May 2007, Maspalomas, Gran Canaria, Spain.

Proceedings of SPIE Vol. **6589**, pp. 65890N/1-65890N/14 (2007) **A**

[78] **J. I. IZPURA**

"Electrical origin of the excess noise in solid-state devices and integrated circuits"

Microtechnologies for the New Millennium 2007, 2-4 May 2007, Maspalomas, Gran Canaria, Spain.

Proceedings of SPIE Vol. **6590**, pp. 65901O/1-65901O/12 (2007) **A**

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos (cont.)

(CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = "review",
E = editor, S = Documento Científico-Técnico restringido.)

Autores (p.o. de firma):

Título:

Ref. revista / Libro: Volumen: Páginas inicial,- final: (Fecha) Clave:

- [79] S. GONZALEZ-CASTILLA, J. MALO, L. VERGARA, J. OLIVARES, M. CLEMENT, **J. I. IZPURA**, J. SANGRADOR; E. IBORRA
"MEMS actuated piezoelectrically with AlN films", CDE07: 6^a Conf. Disp. Electrónicos. Jan 30-Feb 2nd, 2007, San Lorenzo de El Escorial, Madrid, Spain.
IEEE Conf. Proceedings, pp. 226-229, DOI: 10.1109/SCED.2007.384033 (2007) **A**
- [80] M. CLEMENT, S. GONZALEZ-CASTILLA, J. OLIVARES, J. MALO, **J.I. IZPURA**, E. IBORRA, J. SANGRADOR
"Frequency Characterization of AlN piezoelectric resonators" IEEE Conf. Proceedings of the European Frequency and Time Forum (**EFTF_IEEE-FCS'07**), pp. 374-377 (2007) **A**
- [81] **J. I. IZPURA**
"1/f Noise in Planar Resistors: The Joint Effect of a Backgating Noise and an Instrumental Disturbance"
IEEE Trans. Instrum. Meas. **57** (3), pp. 509-517 (2008) <http://dx.doi.org/10.1109/TIM.2007.911642> **A**
- [82] S. GONZÁLEZ-CASTILLA, J. OLIVARES, M. CLEMENT, E. IBORRA, J. SANGRADOR, J. MALO, **J.I. IZPURA**
"Electrical detection of the mechanical resonances in AlN-actuated microbridges for mass sensing applications"
Appl. Phys Lett., Vol. **92**, (18) pp. 183506/1-3 (2008) **A**
- [83] S. GONZÁLEZ-CASTILLA, J. OLIVARES, E. IBORRA, M. CLEMENT, J. SANGRADOR, J. MALO, **I. IZPURA**
"Piezoelectric Microresonators Based on Aluminum Nitride for Mass Sensing Applications".
Proc. IEEE Sensors 2008 Conference, pp. 486-489, October, 26-29 Lecce (ITALY) (2008). **A**
- [84] J. MALO, **J. I. IZPURA**
"Feedback-induced phase noise in microcantilever-based oscillators"
Sensors and Actuators A: Phys. **155**, pp. 188-194 (2009) **A**
- [85] **J. I. IZPURA**
"On the electrical origin of flicker noise in vacuum devices"
IEEE Trans. Instrum. Meas. **58** (10), pp. 3592-3601 (2009)
<http://dx.doi.org/10.1109/TIM.2009.2018692> **A**
- [86] J. MALO, **J. I. IZPURA**
"Feedback-induced Phase noise in resonator-based oscillators"
Proc. of the DCIS'09: XXIV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems, pp. 231-236, November 18-20, Zaragoza (SPAIN) (2009). **A**
- [87] **J. I. IZPURA**, J. MALO
"A Fluctuation-Dissipation model for electrical noise"
Circuits and Systems (Open Access Journal) **2** (3), pp. 112-120 (2011)
<http://dx.doi.org/10.4236/cs.2011.23017> **A**
- [88] **J. I. IZPURA**
"Revisiting the Classics to recover the Physical Sense in electrical noise"
Journal of Modern Physics (Open Access Journal) **2** (6), pp. 457-462 (2011)
<http://dx.doi.org/10.4236/jmp.2011.26055> **A**

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos (cont.)

(CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = "review",
E = editor, S = Documento Científico-Técnico restringido.)

Autores (p.o. de firma):

Título:

Ref. revista / Libro: Volumen: Páginas inicial,- final: (Fecha) Clave:

- [89] **J. I. IZPURA**, J. MALO
 "Thermodynamical phase noise in oscillators based on L-C resonators (Foundations)"
Circuits and Systems **3** (1), pp. 48-60 (2012) <http://dx.doi.org/10.4236/cs.2012.31008> **A**
- [90] J. MALO, **J. I. IZPURA**
 "Thermodynamical phase noise in oscillators based on L-C resonators"
Circuits and Systems **3** (1), pp. 61-71 (2012) <http://dx.doi.org/10.4236/cs.2012.31009> **A**
- [91] **J. I. IZPURA**
 "On the absence of carrier drift in two-terminal devices and the origin of their lowest resistance per carrier
 $R_K = h/q^2$ "
Journal of Modern Physics **3** (8), pp. 762-773 (2012) <http://dx.doi.org/10.4236/jmp.2012.38100> **A**
- [92] **J. I. IZPURA**
 "Surface-Assisted Luminescence: the PL Yellow-Band and the weak EL of n-GaN Devices"
[arXiv:1210.0860v1](https://arxiv.org/abs/1210.0860v1) [cond-mat.mtrl-sci] **A**
- [93] **J. I. IZPURA**
 "Surface-Assisted Luminescence: the PL Yellow-Band and the weak EL of n-GaN Devices"
Advances in Condensed Matter Physics, Vol. 2013, Article ID 597265, 10 pages, ISSN: 1687-8108
<http://dx.doi.org/10.1155/2013/597265> **A**
- [94] **J. I. IZPURA**
 "Electrical Noise under the Fluctuation-Dissipation framework"
[arXiv:1404.6099](https://arxiv.org/abs/1404.6099) [cond-mat.stat-mech] (2014) **A**
- [95] **J. I. IZPURA**
 "Electrical noise, Brownian motion and the Arrow of time"
Journal of Modern Physics **6**, pp. 131-140 (2015) <http://dx.doi.org/10.4236/jmp.2015.62018> **A**
- [96] **J. I. IZPURA**
 "Particle-wave duality in electrical noise"
[arXiv:1512.07149v2](https://arxiv.org/abs/1512.07149v2) [cond-mat.other] (2015) **A**
- [97] **J.I. IZPURA**
 "A quantum model for voltage noise: Theory and Experiments"
[arXiv:1709.06940v1](https://arxiv.org/abs/1709.06940v1) [cond-mat.mes-hall] (2017) **A**
- [98] **J.I. IZPURA**
 "Learning to measure resistance noise demystifies the ubiquitous 1/f excess noise."
[arXiv:1902.10487v1](https://arxiv.org/abs/1902.10487v1) [cond-mat.other] (2019) **A**
- [99] H. GÓMEZ-POZOS, A. MALDONADO, **J.I. IZPURA**, E. MUÑOZ
 "III-Nitride-based junction devices round contacts: effect of semiconductor film geometry and characteristics on the capacitance and conductance measurements"
 DOI: 10.1007/s10854-019-01459-x
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Springer Professional (2019) **A**

Participación en contratos de I+D+i de especial relevancia con empresas y/o administraciones
(nacionales y/o internacionales)

Programa COINCIDENTE: (5 años).

Contratos de Asistencia **P96 0920 225** (año 1996) **P97 0920 282** (año 1997) **P97 0920 411** (año 1998) **P99 0920 182** (año 1999) y **P00 0920 209** (año 2000) entre la Universidad Politécnica de Madrid y el CIDA. Financiación: Ministerio de Defensa-CIDA (Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada). Desde Enero 1996 hasta Diciembre 1999 (4 años iniciales) y desde Enero 2000 hasta Diciembre 2000.
Investigador Responsable: José Luis Sánchez de Rojas Aldavero
Número de Investigadores participantes: **4**

Proyecto ESPRIT N° 35112 "GaAs High Index Substrates for Optoelectronics (GHISO)"

Enero 1999-Diciembre 2000. Financiación: Unión Europea, ESPRIT 35112. E.C. (840.000 euros)
Partners: Univ. Sheffield (U.K.), CNRS-LAAS Toulouse (France), Thomson-LCR (France), UPM (Spain).
Desde Enero 1999 hasta Diciembre 2000.
Investigador Responsable: José Ignacio Izpura Torres (Coordinador)
Número de Investigadores participantes: **16**

Proyectos FIBOPTI y MONILIN sobre diseño de sistemas analógicos a medida para seguridad EM.

Financiación: **Ministerio de Defensa-Centro Nacional de Inteligencia.** (Presupuesto: 24.000 euros)
Julio 2003-Diciembre 2003.
Investigador Responsable: José Ignacio Izpura Torres
Número de Investigadores participantes: **1**

Proyecto "Desarrollo de un sistema de control avanzado del riego en cultivos extensivos"

Diciembre 2003-Octubre 2004.
Financiación: **S.A.T. San Telmo (N° 6043).** (Presupuesto: 32.255 euros)
Investigador Principal: Octavio Nieto-Taladriz García (ETSIT-UPM).
Número de Investigadores participantes: **3**

Proyecto "Desarrollo de un sistema de telegestión para cultivos agrícolas intensivos protegidos"

Enero 2004-Enero 2005.
Financiación: **PRIMA-RAM S.A.** (Presupuesto: 108.000 euros)
Investigador Principal: Octavio Nieto-Taladriz García (ETSIT-UPM).
Número de Investigadores participantes: **3**

Proyecto KIFOAP sobre diseño de sistemas a medida para aplicaciones TEMPEST.

Financiación: **Ministerio de Defensa-Centro Nacional de Inteligencia.** (Presupuesto: 12.000 euros)
Julio 2004-Diciembre 2004.
Investigador Responsable: José Ignacio Izpura Torres
Número de Investigadores participantes: **2**

Título del contrato/proyecto:

Tipo de contrato:

Empresa/administración financiadora:

Entidades participantes:

Duración, desde: hasta:

Investigador responsable:

Número de investigadores participantes:

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO:

Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso.

Patentes y modelos de utilidad

Inventores (p.o. de firma): **José Ignacio Izpura**

Título: **Método para reducir el exceso de ruido en dispositivos electrónicos y en circuitos integrados monolíticos**

N. de solicitud: **P200502744** País de prioridad: **España** Fecha de prioridad: **10_Nov_2005**

Entidad titular: **Universidad Politécnica de Madrid**

Inventores (por orden de firma):

Título:

N.º de solicitud:

País de prioridad:

Fecha de prioridad:

Entidad titular:

Países a los que se ha extendido:

Empresa/s que la están explotando:

Estancias en centros extranjeros (estancias continuadas superiores a un mes)

CLAVE: D = doctorado, P = posdoctoral, I = invitado, C = contratado, O = otras (especificar).

DEPT. OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL ENGINEERING. UNIVERSITY OF SHEFFIELD

Sheffield

Reino Unido

Agosto 1991

1 mes

“Estudio de Técnicas de Caracterización Electroóptica en el dominio del tiempo para Materiales y Dispositivos de Comunicaciones Ópticas”

(Prof. P.N. Robson)

I

DEPT. OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING. UNIVERSITY OF COLORADO

Boulder

Colorado (USA)

Junio/Julio 1999

2 semanas

“Estudio de propiedades optoelectrónicas de pozos cuánticos piezoeléctricos MBE(111)B y MOVPE(111)A”

(Prof. A. Majerfeld)

I

Centro:

Localidad:

País

Fecha:

Duración (semanas):

Tema:

Clave:

Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso.

Contribuciones a Congresos

Autores:

Título:

Congreso: Publicación: Lugar de celebración: Fecha: Carácter (Nacional/ Internacional)

[1] J.M. HERRERO, E. CALLEJA, F. SANDOVAL, **I. IZPURA**, E. MUÑOZ

"Determinación de Niveles Profundos por Transitorios de Capacidad Bajo Condiciones de Resonancia"
Seminario Avanzado Sobre Materiales y Procesos Tecnológicos en Microelectrónica, Libro de resúmenes.
Segovia (1982). **Nacional**

[2] A.I. CODOCEO, **I. IZPURA**, E. MUÑOZ

"Simulación de compuestos III-V para dispositivos de comunicaciones ópticas"
Proc. II Jornadas de Comunicaciones Ópticas. Madrid (1985). **Nacional**

[3] F. SANDOVAL, J.M. HERRERO, **I. IZPURA**, E. LAPEÑA

"LED's de GaAlAs de simple y doble heteroestructura fabricados por epitaxia
en fase líquida (L.P.E.): características"
Tercera Escuela de Microelectrónica. Univ. Autónoma de Barcelona. Barcelona, Dic. (1986). **Nacional**

[4] J.M. HERRERO, F. SANDOVAL, A. BENSOUSSAN, **I. IZPURA**, B. JIMENEZ

"High efficiency GaAlAs red led's (660nm) with single and double heterostructure".
MELECON'87: 34th Mediterranean Electrotechnical Conference. Rome - ITALY, March 24-26, 1987.
The Institute of Electrical and Electronics Engineers. pp. 297-300, 87 CH 2425-7 (1987) **Internacional**

[5] P. CAMARA, E. MUÑOZ, **I. IZPURA**, J. LABLANCA, E. LAPEÑA, M.A. PATE, G. HILL,
P. MISTRY, J. ROBERTS, H.Y. HALL

"Emitter Concentration and Interface Effects in the Base-Emitter Characteristics of GaAlAs/GaAs
Heterojunction Bipolar Transistors". **ESSDERC-87**: 17th European Solid State Device Research
Conference. Bologna- ITALY. September 1987.
Solid State Devices. pp. 979-982. North Holland, (1988) **Internacional**

[6] **I. IZPURA**, E. MUÑOZ, E. CALLEJA, G. HILL, J. ROBERTS, M.A. PATE, P. MISTRY, N.Y. HALL

"DX Centers and the Low Temperature Behavior of AlGaAs/GaAs Heterojunction Bipolar Transistors"
IC-STDCS: International Conference on the Science and Technology of Defect Control in
Semiconductors
Yokohama – JAPAN, September 1989. Defect Control in Semiconductors, K. Sumino (ed), pp.
1267-1272.
Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland) (1990) **Internacional**

[7] S. DUEÑAS, **I. IZPURA**, M. JARAIZ, J. BARBOLLA

"Caracterización de centros DX en AlGaAs:Si"
Libro de Comunicaciones V Escuela de Microelectrónica, pp. 115-118.
Quinta Escuela de Microelectrónica. Granada 24-28 de Septiembre (1990). **Nacional**

[8] E. MUÑOZ, A. MANESCAU, F. GONZALEZ, F. GARCIA, **I. IZPURA**, E. CALLEJA,
"Some Material Issues in InGaAs based Transistors"

WOCSDICE 90: 14th European Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated
Circuits.
Libro de Abstracts. Cardiff, Reino Unido. May 7-10th (1990). **Internacional**

[9] J. M. HERNANDEZ, **I. IZPURA**, F. GONZALEZ-SANZ, E. CALLEJA, E. MUÑOZ,
S. A. CLARK, A. GEORGAKILAS

"Conduction band offset determination in PM InGaAs-InAlAs interface by resonant tunneling
spectroscopy", **WOCSDICE 92**: 16th European Workshop on Compound Semiconductor Devices and
Integrated Circuits. Libro de Abstracts. San Rafael-Segovia, Spain. May 24-27 (1992). **Internacional**

Contribuciones a Congresos (cont.)

[10] E. MUÑOZ, E. CALLEJA, I. IZPURA, F. GARCIA, A.L. ROMERO, F. BLANCO, J.L. SANCHEZ-ROJAS

“Techniques to Minimize DX Center Deleterious Effects in III-V Device Performance”

WOCSDICE 92: 16th European Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits. Libro de Abstracts. San Rafael-Segovia, Spain. May 24-27 (1992). **Internacional**

[11] L. ENRIQUEZ, S. DUEÑAS, J. BARBOLLA, I. IZPURA, E. MUÑOZ

“Refilling Effects and Capture Barriers of DX Centers in Se-doped $Al_xGa_{1-x}As$ ”

WOCSDICE 92: 16th European Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits. Libro de Abstracts. San Rafael-Segovia, Spain. May 24-27 (1992). **Internacional**

[12] I. IZPURA, E. MUÑOZ, E. CALLEJA, F. GARCIA

“DX Centers in reduced dimensionality n-type AlGaAs structures”

ICDS-17: 17th Int. Conference on Defects in Semiconductors. Gmunden, AUSTRIA, July 1993.

Defects in Semiconductors, H. Heinrich and W. Jantsch (ed.), pp. , 623-628.

Materials Science Forum Vol. 143-147, Trans Tech Publications (1994) **Internacional**

[13] I. IZPURA, J.F. VALTUEÑA, J.L. SANCHEZ-ROJAS, A. SACEDON, E. CALLEJA, E. MUÑOZ
“Transient Negative Photocurrent and Out-of-well Dipole Kinetics in Novel Piezoelectric InGaAs/GaAs MQW P-I-N Diodes”

MSS7: 7th Int. Conference on Modulated Semiconductor Structures. Madrid, Julio (1995) **Internacional**

[14] J.L. SANCHEZ-ROJAS, E. MUÑOZ, A. SACEDON, J.F. VALTUEÑA, I. IZPURA, E. CALLEJA

“Field Control in Piezoelectric [111]-Oriented InGaAs/GaAs MQW and Superlattice Devices”

15th Biennial IEEE/Cornell Conference on Advanced Concepts in High Speed Semiconductor Devices and Circuits. Ithaca, USA, August (1995). **Internacional**

[15] A. SANZ-HERVAS, J.F. VALTUEÑA, M. GARRIDO, J.P.R. DAVID, C.VILLAR, E.J. ABRIL
M. AGUILAR, I. IZPURA, R. GREY, F. GONZALEZ-SANZ, R. LORENZO, M. LOPEZ

“High-resolution X-ray diffraction study of partially relaxed InGaAs/GaAs multiquantum well p-i-n diodes on (001) GaAs”

45th Annual Conf. on Applic. of X-ray analysis. Denver (CO) USA, August 3-8 (1996). **Internacional**

[16] J.F. VALTUEÑA, I. IZPURA, J.L. SANCHEZ-ROJAS, E. MUÑOZ, E.A. KHOO, J.P.R. DAVID,
J. WOODHEAD, R. GREY, G.J. REES

”Memory Effects on Piezoelectric InGaAs/GaAs MQW PIN diodes”

NIS 96: 2nd Int. Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces, Lyon, France, October (1996) **Internacional**

[17] J.L. SANCHEZ-ROJAS, A. SACEDON, J.F. VALTUEÑA, A. SANZ-HERVAS,
I. IZPURA, E. CALLEJA, E. MUÑOZ, E.J. ABRIL, M. AGUILAR

“Charge Accumulation Effects in InGaAs/GaAs [111]-Oriented Piezoelectric Multiple Quantum Wells”

NIS 96: 2nd Int. Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces, Lyon, France, October (1996) **Internacional**

[18] I. IZPURA, E. MUÑOZ

“Epitaxial photoconductive detectors: a kind of photo-FET devices”

WOFE 97: Advanced Workshop on Frontiers in Electronics. Pto. de la Cruz, Tenerife, Spain, January 1997.

IEEE Proc. No. 97TH8292, pp. 73-80, (1997) **Internacional**

[19] I. IZPURA, E. MUÑOZ

“Epitaxial photoconductive detectors: a kind of photo-FET devices”

CDE 97: 1^a Conferencia de Dispositivos Electrónicos. Barcelona, España. Febrero 1997.

Libro de Actas de CDE97. pp. 151-156 Servei de Publicacions de la UPC. (1997). **Nacional**

Contribuciones a Congresos (cont.)

- [20] J.L. SANCHEZ-ROJAS, E. MUÑOZ, A. SACEDON, J.F. VALTUEÑA, I. IZPURA, E. CALLEJA
"Optoelectronic properties of piezoelectric [111]-oriented InGaAs/GaAs MQW and superlattice devices"
CDE 97: 1ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos. Barcelona, España. Febrero 1997.
Libro de Actas de CDE97. pp. 151-156 Servei de Publicacions de la UPC. (1997). **Nacional**
- [21] J.J. SANCHEZ, M. HOPKINSON, E.A. KHOO, C. VILLAR, A. SANZ-HERVAS, I. IZPURA,
A. GUZMAN, J.L. SANCHEZ-ROJAS, E. CALLEJA
"Influence of substrate misorientation on the growth and properties of $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ quantum well
structures grown on (111)B GaAs". **IX European Workshop on MBE**. Libro de Abstracts.
Oxford, Reino Unido. 6-10 Abril (1997). **Internacional**
- [22] J.J. SANCHEZ, M. HOPKINSON, E.A. KHOO, C. VILLAR, A. SANZ-HERVAS, I. IZPURA,
A. GUZMAN, J.L. SANCHEZ-ROJAS, E. CALLEJA
"Wafer dependent structural and optical characterization of $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ MQW-PIN structures on
(111)B GaAs grown by MBE"
LDS D 97: 2nd International Conference on Low Dimensional Structures & Devices. Libro de Abstracts.
Lisbon, Portugal. 19-21 Mayo (1997). **Internacional**
- [23] E. MONROY, J.A. GARRIDO, E. MUÑOZ, I. IZPURA, F.J. SÁNCHEZ, M.A. SÁNCHEZ-GARCIA
E. CALLEJA, B. BEAUMONT, P. GIBART
"Characterization and modelling of photoconductive GaN UV detectors"
2nd European GaN Workshop. Cannes, France. June (1997). **Internacional**
- [24] A. SANZ-HERVAS, C. VILLAR, M. GARRIDO, J.F. VALTUEÑA, J.P.R. DAVID, J.S. ROBERTS
M.A.G. HALLIWELL, E.J. ABRIL, M. LOPEZ, I. IZPURA
"Asymmetric lattice distortion in pseudomorphic multilayers grown on misoriented substrates"
46th Annual Conference on Applications of X-ray analysis. Steamboat Springs, Colorado, USA,
August 4-8 (1997). **Internacional**
- [25] C. ARANBURU, M. GALARZA, M. LOPEZ-AMO, J.L. SANCHEZ, J. I. IZPURA
"Optimización de factores de mérito ópticos de un modulador electroabsorbente de múltiple pozo cuántico sobre
InGaAs/GaAs", **URSI-1997**: XII Simposium Nacional de la unión científica internacional de radio. Vol II, pp
41-44. Bilbao, 15-17 Septiembre (1997). **Nacional**
- [26] J.A. GARRIDO, F. CALLE, I. IZPURA, E. MUÑOZ, J.L. SANCHEZ-ROJAS, R. LI, K.L. WANG
"Low-frequency noise studies in AlGaIn/GaN HEMTs"
WOCSDICE 98: 22nd Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits.
Libro de Abstracts. Zeuthen-Berlin, Germany. May 24-27 (1998). **Internacional**
- [27] J.A. GARRIDO, F. CALLE, E. MUÑOZ, I. IZPURA, J.L. SANCHEZ-ROJAS, R. LI, K.L. WANG
"Low-frequency noise sources in AlGaIn/GaN HEMTs"
7th Van Der Ziel Symposium on Quantum 1/f noise and other low frequency fluctuations in electronic devices, St.
Louis (Missouri) USA, August 1998.
AIP Conference Proceedings 466, P.H. Handel and A.L. Chung (ed.), pp. 71-83 (1999) **Internacional**
- [28] M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.J. SANCHEZ, I. IZPURA, M. HOPKINSON,
R. GARCIA
"Influence of Substrate Misorientation on the Structural Characteristics of InGaAs Quantum Wells
on (111)B grown by MBE". Libro de Abstracts.
ICSS-10: 10th Int. Conference on Solid Surfaces, 14th Int. Vacuum Congress, 5th Int. Conference on
Nanometer-scale Science and Technology, 10th International Conference on Quantitative Surface Analysis.
Birmingham, Reino Unido. 31 Agosto-4 Septiembre (1998). **Internacional**

Contribuciones a Congresos (cont.)

- [29] J.J. SANCHEZ, M. HOPKINSON, M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, I. IZPURA, R. GARCIA
“Optical properties of $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ MQW structures on (111)B GaAs grown by MBE : dependence with substrate miscut”
MBE-X : 10th International Conference on Molecular Beam Epitaxy. Poster presentation. Cannes, France. 31 Agosto-4 Septiembre (1998). **Internacional**
- [30] J.L. SANCHEZ-ROJAS, E. MUÑOZ, I. IZPURA, A. SACEDON, J.F. VALTUEÑA, E. CALLEJA
“Optoelectronic effects and devices based on strained piezoelectric quantum wells”
ICSMM-11: 11th International Conference on Superlattices, Microstructures and Microdevices. Hurghada (Red Sea) Egipto. July 27- August 1 (1998). **Internacional**
- [31] I. IZPURA, J.J. SANCHEZ, J.L. SANCHEZ-ROJAS, E. MUÑOZ
“Piezoelectric field determination in strained InGaAs quantum wells grown on [111]B GaAs substrates by differential electroabsorption”. Libro de Abstracts.
NIS 98: 3rd Int. Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces, San Rafael-Segovia, Spain. October 6-9th (1998). **Internacional**
- [32] J.J. SANCHEZ, M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.M.G. TIJERO, J.L. SANCHEZ-ROJAS, I. IZPURA, R. GARCIA
“Influence of substrate misorientation on the optical and structural properties of InGaAs/GaAs Single Strained Quantum Wells grown on (111)B GaAs by Molecular Beam Epitaxy”. Libro de Abstracts.
NIS 98: 3rd Int. Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces, San Rafael-Segovia, Spain. October 6-9th (1998). **Internacional**
- [33] J.J. SANCHEZ, J.M.G. TIJERO, J. HERNANDO, J.L. SANCHEZ-ROJAS, I. IZPURA
“Optical investigation of the relaxation process in InGaAs/GaAs SSQW grown on (001) and (111)B GaAs substrates”. Libro de Abstracts.
NIS 98: 3rd Int. Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces, San Rafael-Segovia, Spain. October 6-9th (1998). **Internacional**
- [34] M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.J. SANCHEZ, I. IZPURA, R. GARCIA
“New relaxation mechanism in InGaAs/GaAs (111) MQW grown by MBE”. Libro de Abstracts.
NIS 98: 3rd Int. Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces, San Rafael-Segovia, Spain. October 6-9th (1998). **Internacional**
- [35]] M.J. ROMERO, M. GUTIERREZ, J.J. SANCHEZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, I. IZPURA, R. GARCIA
“Cathodoluminescence study of pyramidal facets in piezoelectric InGaAs/GaAs multiple quantum well p-i-n photodiodes”. Libro de Abstracts.
NIS 98: 3rd Int. Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces, San Rafael-Segovia, Spain. October 6-9th (1998). **Internacional**
- [36] M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.J. SANCHEZ, I. IZPURA, R. GARCIA
“Study of the relaxation in InGaAs SQW grown on (111)B substrates”. Libro de Abstracts.
11th International Conference on **Microscopy of Semiconducting Materials**
Oxford, Reino Unido. 22-25 March. (1999). **Internacional**
- [37] M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.J. SANCHEZ, I. IZPURA, R. GARCIA
“Estructura de defectos en multipozos cuánticos de InGaAs/GaAs crecidos sobre sustratos desorientados de GaAs (111)B”. Libro de resúmenes. ISBN 84-699-0099-4
XIX Reunión Bienal de la Sociedad Española de Microscopía Electrónica.
Murcia, España. 28-30 Abril (1999). **Nacional**

Contribuciones a Congresos (cont.)

- [38] J.J. SANCHEZ, R. MAMY, C. FONTAINE, **I. IZPURA**
"GaAs and (Ga,Al)As layers on GaAs (111)B substrates tilted towards [2-1-1] and [-2,1,1]: Comparison of growth conditions and surface morphology".
X European Workshop on MBE. Libro de abstracts.
Les Arcs (Savoie) France. April 1999. **Internacional**
- [39] M.J. ROMERO, M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.J. SANCHEZ, **I. IZPURA**, R. GARCIA
"Estudio de la actividad eléctrica y óptica de microfacetas en fotodiodos piezoeléctricos de múltiples pozos cuánticos de InGaAs/GaAs (111)B"
VI Reunión Nacional de Materiales. Libro de resúmenes, pp 400-401. ISBN 84-923445-7-1.
San Sebastián, España. 22-24 Junio (1999). **Nacional**
- [40] M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.J. SANCHEZ, **I. IZPURA**, R. GARCIA
"Relajación en pozos cuánticos de InGaAs/GaAs sobre sustratos (001) y (111)B de GaAs"
VI Reunión Nacional de Materiales. Libro de resúmenes, pp 408-409. ISBN 84-923445-7-1.
San Sebastián, España. 22-24 Junio (1999). **Nacional**
- [41] D. MORENO, J.J. SANCHEZ, **I. IZPURA**, J.L. SANCHEZ-ROJAS, J.M.G. TIJERO, E. MUÑOZ
"In_xGa_{1-x}As/GaAs Quantum-Well lasers on (111)B GaAs substrates for long wavelength applications"
CDE99: 2ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos. Madrid, España. Junio 1999.
Actas de la 2ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE99). pp. 217-218 (1999), **Nacional**
Repromarket S.A. ISBN 84-00-07819-5
- [42] S. CHO, J. KIM, A. MAJERFELD, J.J. SANCHEZ, E. MUÑOZ, **I. IZPURA**
"Evaluation of strained piezoelectric InGaAs/GaAs QW structures grown on (111)B GaAs by photoreflectance spectroscopy". **27th IEEE Int. Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2000)**
Monterrey (CA) USA. 2-5 October (2000), **Internacional**
Proceedings of the IEEE, ISBN: 0-7803-6285-6
- [43] M. HERRERA, M. GUTIERREZ, D. GONZALEZ, G. ARAGON,
I. IZPURA, M. HOPKINSON, R. GARCIA
"The role of climb and glide in misfit relief of InGaAs/GaAs (111)B Heterostructures"
NIS 01: 4th Int. Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces, Aspet, France. September 16-20th (2001). **Internacional**
- [44] M. GUTIERREZ, M. HERRERA, D. GONZALEZ, G. ARAGON, J.J. SANCHEZ,
I. IZPURA, M. HOPKINSON, R. GARCIA
"Relaxation study of AlGaAs cladding layers in InGaAs/GaAs (111)B lasers designed for 1.0-1.1 μm operation"
NIS 01: 4th Int. Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces, Aspet, France. September 16-20th (2001). **Internacional**
- [45] J.M. ULLOA, L. BORRUEL, J.M.G. TIJERO, J. TEMMYO, I. ESQUIVIAS,
I. IZPURA, J.L. SANCHEZ-ROJAS
"Spontaneous emission study of (111) InGaAs/GaAs Quantum Well lasers"
NIS 01: 4th Int. Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces, Aspet, France. September 16-20th (2001). **Internacional**
- [46] S. CHO, A. MAJERFELD, A. SANZ-HERVAS, J.J. SANCHEZ, E. MUÑOZ,
J.M.G. TIJERO, **I. IZPURA**
"Observation of the Pyroelectric Effect in Strained Piezoelectric InGaAs/GaAs Quantum-Wells grown on (111) GaAs Substrates"
NIS 01: 4th Int. Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces, Aspet, France. September 16-20th (2001). **Internacional**

Contribuciones a Congresos (cont.)

[47] **I. IZPURA**

“Simulation and characterization of piezoelectric InGaAs/GaAs quantum well lasers grown on (111)B GaAs”
NIS 01: 4th Int. Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces, Aspet, France. September 16-20th (2001). (Conferencia Invitada). **Internacional**

[48] **J. I. IZPURA**

“El papel de la resistencia de contacto de drenador en el colapso de I_d en transistores FET de GaN para microondas”

URSI-2002: XVII Simposium Nacional de la unión científica internacional de radio. Libro abstracts URSI 2002, pp 201-202. ISBN 84 – 8138-517-4. Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá de Henares.

Alcalá de Henares, Madrid, España. 11-13 Septiembre (2002). **Nacional**

[49] A. ARAUJO, J.M. MONTERO, D. FRAGA, **J. I. IZPURA**, O. NIETO-TALADRIZ

“ANTARES: Una Integración de Docencia Universitaria e (I+D+I) en una misma Plataforma”

TAAE-2004: VI Congreso sobre Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, España. 14-16 Julio de 2004. **Nacional**

[50] O. NIETO-TALADRIZ, A. ARAUJO, D. FRAGA, J.M. MONTERO, **J. I. IZPURA**

“ANTARES: A synergy between University Education and Research, Development and Technology Innovation Groups”

MIEL 2004: 24th International Conference on Microelectronics.

University of Nis, Serbia and Montenegro. May 16-19th (2004). **Internacional**

[51] J.M. TIRADO, J.L. SANCHEZ-ROJAS, **J.I. IZPURA**

“Numerical 2D simulation of surface states effects in AlGaIn/GaN HEMT and GaN MESFET devices”

WOCSDICE 2005: 29th Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits.

Libro de Abstracts, pp 141-143. Cardiff, United Kingdom. May 15-18th (2005). **Internacional**

[52] J. M. TIRADO, J. L. SANCHEZ-ROJAS, **J. I. IZPURA**

“Numerical 2D simulation of surface states effects in AlGaIn/GaN HEMT and GaN MESFET devices”

IEEE-NANO 2005: 5th IEEE Conference on Nanotechnology. Proceedings of IEEE-NANO 2005.

Nagoya, Japan. July 12-14th (2005). **Internacional**

[53] **J. I. IZPURA**, J. MALO

“1/f noise enhancement in GaAs”

ICNF-2005: 18th International Conference on Noise and Fluctuations. AIP Conference Proceedings, pp 113-116

Salamanca, Spain. September 19-23rd (2005). **Internacional**

[54] J. OLIVARES, J. MALO, S. GONZALEZ, E. IBORRA, **I. IZPURA**, M. CLEMENT, A. SANZ-HERVAS

J.L. SANCHEZ-ROJAS, P. SANZ

“Tunable mechanical resonator with aluminum nitride piezoelectric actuation”

Photonics-Europe Conference on MEMS, MOEMS and Micromachining II, SPIE Europe.

Strasbourg, France. April 3-7. (2006). **Internacional**

[55] **J. I. IZPURA**

“1/f electrical noise due to space charge regions”

Electrocera-X: International Conference on Electroceraamics

Toledo, Spain. June 18-22nd (2006). **Internacional**

Contribuciones a Congresos (cont.)

[56] J. I. IZPURA, J. MALO

"Noise tunability in planar junction diodes: theory, experiment and additional support by SPICE"

TAEE-2006: VII Congreso sobre Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica.

Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España. 12-14 Julio de 2006. **Nacional**

[57] J. I. IZPURA

"A way to reduce noise upconversion effects in GaAs MMICs"

DCIS'06: XXI Conference on Design of Circuits and Integrated Systems

Barcelona, Spain. November 24-26, 2006. **Internacional**

[58] S. GONZALEZ-CASTILLA, J. MALO, L. VERGARA, J. OLIVARES, M. CLEMENT,

J.I. IZPURA, J. SANGRADOR; E. IBORRA

"MEMS actuated piezoelectrically with AlN films"

CDE07: 6ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos. San Lorenzo de El Escorial Madrid, España.

30 Enero-2 Febrero, 2007. **Nacional**

[59] J. MALO, J.I. IZPURA

"Feedback loops with electrically-driven cantilevers"

Microtechnologies for the New Millennium 2007, SPIE Europe

2-4 May 2007, Maspalomas, Gran Canaria, Spain. **Internacional**

[60] J.I. IZPURA

"Electrical origin of the excess noise in solid-state devices and integrated circuits"

Microtechnologies for the New Millennium 2007, SPIE Europe

2-4 May 2007, Maspalomas, Gran Canaria, Spain. **Internacional**

[61] M. CLEMENT, S. GONZALEZ-CASTILLA, J. OLIVARES, J. MALO,

J.I. IZPURA, E. IBORRA, J. SANGRADOR

"Frequency Characterization of AlN piezoelectric resonators" European Frequency and Time Forum

(**EFTF_IEEE-FCS'07**) May 29-June 1, 2007, Ginebra, Suiza. **Internacional**

[62] S. GONZÁLEZ-CASTILLA, J. OLIVARES, E. IBORRA, M. CLEMENT, J. SANGRADOR

J. MALO, I. IZPURA

"Piezoelectric Microresonators Based on Aluminum Nitride for Mass Sensing Applications".

Proc. IEEE Sensors 2008 Conference, pp. 486-489, October, 26-29 Lecce (ITALY) (2008).

Internacional

[63] J. MALO, J. I. IZPURA

"Feedback-induced Phase noise in resonator-based oscillators"

DCIS'09: XXIV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems

Zaragoza, Spain. November 18-20, 2009. **Internacional**

[64] J. I. IZPURA, E. IBORRA, M. CLEMENT

"On the origin of RTS noise in nanoFETs"

TNT 2012: Trends in Nanotechnology International Conference,

ETSII-UPM Madrid, Spain. September 10-14, 2012. **Internacional**

Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso.

Tesis doctorales dirigidas

Título:
Doctorando:
Universidad:
Facultad / Escuela:
Fecha de lectura:
Calificación

Título: "Contribución al Desarrollo de Fotorreceptores de InGaAs y a la Integración de Estructuras Metamórficas sobre Sustratos de GaAs"

Doctorando: Juan Francisco Valtueña Pablo.

Universidad: Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

Fecha de Inicio: Año 1993.

Fecha de Lectura: 29 Julio 1997.

Calificación: Apto Cum Laude por unanimidad y Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, Curso Académico 1996/1997.

Director: Dr. José-Ignacio Izpura Torres.

Título: "Crecimiento por MBE, fabricación y caracterización de láseres de AlGaAs/GaAs/InGaAs/GaAs (111)B para emisión óptica con $\lambda > 1\mu\text{m}$ "

Doctorando: Jorge Julián Sánchez Martínez.

Universidad: Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

Fecha de Inicio: Enero 1996.

Fecha de Lectura: 1 Marzo 2000.

Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.

Director: Dr. José-Ignacio Izpura Torres.

Título: "Efectos de dispersión en transistores de efecto de campo basados en compuestos III-V: Estudio, Caracterización y Modelado"

Doctorando: José María Tirado Martín.

Universidad: Universidad de Castilla La Mancha (UCLM).

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

Fecha de Inicio: Septiembre 2001.

Fecha de Lectura: 1 Diciembre 2006.

Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.

Directores: Dr. José-Luis Sánchez de Rojas Aldavero y Dr. José-Ignacio Izpura Torres.

Título: "Contribución al diseño de lazos de realimentación electrónica para sistemas electromecánicos (MEMS) resonantes: ruido de fase generado en lazos osciladores por sus realimentaciones."

Doctorando: Javier Malo Gómez.

Universidad: Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

Fecha de Inicio: Enero de 2006.

Fecha de Lectura: 11 de Junio de 2015.

Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.

Director: Dr. José-Ignacio Izpura Torres.

Participación en comités y representaciones internacionales

Título del comité:

Entidad de la que depende:

Tema:

Fecha:

Título del comité:

Entidad de la que depende:

Tema:

Fecha:

Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso.

Experiencia en organización de actividades de I+D+i

Organización de congresos, seminarios, jornadas, etc., científico-tecnológicos

Título:

Tipo de actividad:

Fecha:

Ámbito:

- **Miembro del Comité Técnico** de la 1ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos celebrada en Barcelona en Febrero de 1997 (CDE97).
- **Chairman** de la Sesión 1B : “Simulación Física” de la Conferencia CDE97 (Febrero 1997, Barcelona).
- **Tesorero** del Congreso Internacional **NIS-98** (3rd International Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces 6-9 de Octubre de 1998, San Rafael, Segovia, Spain).
- **Miembro del Comité Técnico** del Congreso Internacional **NIS-01** (4th International Workshop on Growth, characterization and exploitation of epitaxial compound semiconductors on Novel Index Surfaces September 16-20th (2001). Aspet, France).

Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso.

Experiencia de gestión de I+D+i

Gestión de programas, planes y acciones de I+D+i

Título:

Tipo de actividad:

Fecha:

- **Evaluador nacional (ANEP)** desde el año 2000, de Proyectos de Investigación, Proyectos de Infraestructura y Becas doctorales y postdoctorales.
- **Miembro del Comité de Expertos** de evaluación de Becas Doctorales y Postdoctorales del Gobierno Vasco, Area 5 (Física-Electrónica). Convocatorias 2001-2002, 02-03, 03-04 y 2004-2005.
- **Miembro de la Comisión de expertos para la selección de solicitudes al Programa TIC en 2001.**
Convocatoria 2001 (Apartado 11.2 de la Orden de 31 de Enero de 2001, BOE de 2 de Febrero).
- **Adjunto al Coordinador del Area de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática de la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva)** desde el 1 de Abril de-2001 hasta el 31 de Enero de 2005.
- **Miembro de las Comisiones de Expertos de la ANEP** (Area de Ing. Eléctrica, Electrónica y Automát.) para:
 - 1- Evaluación del Programa Ramón y Cajal, Convocatoria 2003.
 - 2- Evaluac. del Progr. Nacional de Movilidad de profesores (Resol. 25 de Sept. BOE de 10 de Octubre, 2002)
 - 3- Becas y Ayudas del Conv. Coop. Hispano-Brasileño (Resol. 3 de Marzo, BOE de 20 de Marzo, 2003)
 - 4- Evaluación de los Programas Ramón y Cajal y Juan de La Cierva, Convocatoria 2004.
- **Evaluador de la Comunidad de Madrid** para becas de Formación de Personal Investigador, convocat. 2003
- **Evaluador de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva (ACAP)** de las Universidades de Madrid
(Comité de Evaluación de Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones, Diciembre 2003)
- **Experto de la ANECA para Acreditación de Profesores Titulares** desde 2008.
- **Experto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)** de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, desde 2008.

Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso.

Otros méritos o aclaraciones que se desee hacer constar
(utilice únicamente el espacio equivalente a una página)

- **2 años como Secretario del Departamento de Ingeniería Electrónica** de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desde mi nombramiento el 23 de Enero de 1992 hasta mi cese por propia petición el 6 de Febrero de 1994, tras haber cumplido el plazo de 2 años al que me comprometí para dicho cargo.
- **5 años como Subdirector del Departamento de Ingeniería Electrónica** de la UPM, desde el 4 de Mayo de 1999 hasta el 8 de Junio de 2004.
- **Miembro de Junta de Escuela (representante de Profesores Titulares) entre Julio 1999 y Febrero 2002.**

ASISTENCIA A CURSOS ESPECIALIZADOS:

Asistí al Curso del programa NATO-ASI (Advanced Study Institutes): "Electronic Properties of Multilayers and low Dimensional Semiconductor Structures" del 11 al 22 de Septiembre de 1989 en el Chateau de Bonas (Francia).

MERITOS INVESTIGADORES

- Valoración positiva de **4 Sexenios** de Investigación: 1986-1991, 1992-1997, 1998-2003 y 2004-2009 por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
- **Revisor de:** (1) IEEE Electron Device Letters (desde año 2000), (2) Semiconductor Science and Technology (desde 2001), (3) Microelectronics Journal (desde 2001), (4) Measurement Science and Technology (desde 2003), (5) Journal of Physics D: Applied Physics (desde 2005), (6) IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement (desde año 2007), (7) IEEE Sensors Journal (desde año 2007), (8) IEEE Trans. on Electron Devices (desde año 2008), (9) IEEE_ASME Transactions on Mechatronics (desde año 2008), (10) Sensors and Actuators B (desde año 2008), (11) Sensors and Actuators A (desde año 2009), (12) IET Circuits, Devices & Systems (desde año 2011), (13) IEEE Trans. Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control (desde 2012)
- **Evaluador de los Premios COIT/AEIT** convocatorias 2001→2012.
- **Revisor del congreso SAAEI-2003**, Ann. Symp. on Autom. Ind. Electron. and Instrum. 10th Ed.
- **Revisor de Congresos DCIS-2003, 2004,....., 2015**, XVIII-XXX Conferences on Design of Circuits and Integrated Systems.
- **Chairman del congreso DCIS_2003** en la Sesión 4d, titulada "Device Modeling"
- **Chairman del congreso Electroceramics-X**, (2005) en la Sesión: Poster Session III.

MERITOS DOCENTES

- Valoración positiva de **seis Quinquenios**: 1985-1989, 1990-1994, 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009 y 2010-2015 por la Comisión de Valoración de la Universidad Politécnica de Madrid.
- **Premio a la Innovación Educativa** de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid que se me otorgó como Miembro del equipo de 10 profesores del Departamento de Ingeniería Electrónica que recibió este premio en la Convocatoria de 2006.
- Concesión de un **Premio Extraordinario de Doctorado** de la Universidad Politécnica de Madrid, Curso 1996/1997 a la primera de las Tesis Doctorales dirigidas por el autor de este Currículum.
- Seleccionado para **nueve orlas de Promociones de Ingenieros de Telecomunicación**:
Promoción de 1990-1996 del Plan 64M2, Area Electrónica-Dispositivos;
Promociones: 1995-2000, 1996-2001, 1998-2003, 2000-2005, 2001-2006, 2002-2007, 2003-2008 y 2004-2009 de la Especialidad Electrónica del Plan 94.
- **Premio Mejor Profesor de Grupos Reducidos** en la 1^a convocatoria **TOP-Profe-2004** organizada por Delegación de Alumnos de la ETSI Telecomunicación, Univ. Politécnica de Madrid, Mayo 2004
- **2º Clasif. en Mejor Profesor de Grupos Reducidos** en su 2^a convocatoria "**TOP-Profe-2005**".
- Seleccionado para **dos orlas (2016 y 2017) del Master Universitario de Ingeniería Aeroespacial.**

Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso.